

# 強い電場による 真空や半導体からの 自発的なスピンの生成

田屋 英俊  
(Fudan University)

共同研究者: Xu-Guang HUANG (Fudan), 松尾衛 (UCAS, 理研, 原研)

Ref: [Huang, Matsuo, [HT](#), arXiv:1904.07593 (to appear in PTEP)]

# 言いたいこと

1

高エネルギー物理のSchwinger機構(強い電場による真空/基底状態からの粒子生成)を利用した**新しいスピンの生成機構の提案**

2

フェルミ面がギャップの中にあるDirac物質 (QED真空, グラフェン, Dirac半金属, 半導体,...) に、2種類の電場 (定常電場 + 横方向の振動電場) を重ねると、スピンの生成が自発的に生成

3

線形近似では記述できない非線形効果  
伝導電子や特殊な条件(不純物、対称性の破れ、スピン依存したバンドなど)は不要

導入



理論



結果



まとめ

# 強い電場による粒子生成

- ギャップよりも「強い」電場を真空/基底状態に加えると、価電子帯から電子が励起され、電子・正孔対が生成される



# 強い電場による粒子生成

- ギャップよりも「強い」電場を真空/基底状態に加えると、価電子帯から電子が励起され、電子・正孔対が生成される



- 電場の周波数 $\Omega$  ( $E = E_0 \cos(\Omega t)$ ) に応じ、三種類に大別できる
  - 高エネルギーでの名前      物性での名前
  - (1) 遅い電場 ( $\Omega$ 小)      Schwinger機構 / Landau-Zener機構
  - (2) 速い電場 ( $\Omega$ 大)      multi-photon pair production / (内部) 光電効果
  - (3) 重ね合わせ  
(遅い+速い電場)      dynamically assisted Schwinger 機構  
Franz-Keldysh 効果

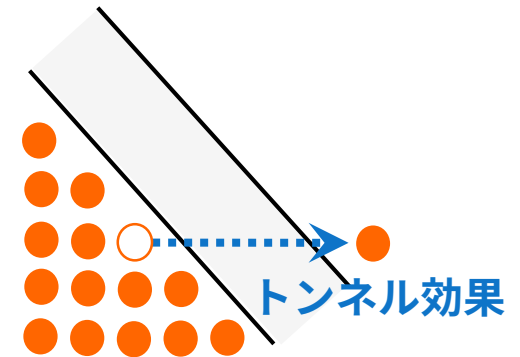
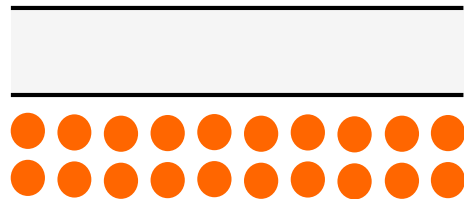
# (1) 電場が遅いとき

## Schwinger機構 / Landau-Zener機構

[Sauter (1932)] [Heisenberg, Euler (1936)]  
[Schwinger (1951)]

[Landau (1932)] [Zener (1932)]  
[Majorana (1932)] [Stueckelberg (1932)]

- 電場がバンドを曲げる  $\Rightarrow$  level crossing  $\Rightarrow$  非摂動的なトンネル効果



# (1) 電場が遅いとき

## Schwinger機構 / Landau-Zener機構

[Sauter (1932)] [Heisenberg, Euler (1936)]  
[Schwinger (1951)]

[Landau (1932)] [Zener (1932)]  
[Majorana (1932)] [Stueckelberg (1932)]

- 電場がバンドを曲げる  $\Rightarrow$  level crossing  $\Rightarrow$  非摂動的なトンネル効果



- 生成電子スペクトルは、ガウシアンで、スピンの依存しない

$$\frac{d^3 N_{\uparrow}}{dp^3} = \frac{d^3 N_{\downarrow}}{dp^3} \propto \exp\left[-\frac{\pi(m^2 + p_T^2)}{eE}\right]$$



スピン流は流れない

# (2) 電場が速いとき

## multi-photon pair production / 光電効果

[Brezin, Izykson (1970)] [HI, Fujii, Itakura (2014)]

[Einstein (1905)]

- 光子の粒子性が効いてくる  $\Rightarrow$  光子と摂動的に多重散乱





## (2) 電場が速いとき

### multi-photon pair production / 光電効果

[Brezin, Izykson (1970)] [HI, Fujii, Itakura (2014)]

[Einstein (1905)]

- 光子の粒子性が効いてくる  $\Rightarrow$  光子と摂動的に多重散乱



- 生成電子スペクトルは、デルタ関数で、(偏向しなければ) スピンに依存しない

$$\frac{d^3 N_{\uparrow}}{dp^3} = \frac{d^3 N_{\downarrow}}{dp^3} \propto \sum_n \left( \frac{eE}{m^2 + p^2} \right)^{2n} \delta(2\sqrt{m^2 + p^2} - n\Omega)$$



スピン流は流れない

# (3) 重ね合わせたとき

## dynamically assisted Schwinger 機構 / Franz-Keldysh 効果

[Dunne, Gies, Schutzhold (2008), (2009)] [Piazza et al (2009)]  
[Monin, Voloshin (2010)] [HT (2019)]

[Franz (1958)] [Keldysh (1958)]

- 遅い電場による非摂動トンネル効果 + 速い電場による摂動的な多重散乱



# (3) 重ね合わせたとき

## dynamically assisted Schwinger 機構 / Franz-Keldysh 効果

[Dunne, Gies, Schutzhold (2008), (2009)] [Piazza et al (2009)]  
[Monin, Voloshin (2010)] [HT (2019)]

[Franz (1958)] [Keldysh (1958)]

- 遅い電場による非摂動トンネル効果 + 速い電場による摂動的な多重散乱



- 粒子生成の様子は、単なる重ね合わせで理解できない

e.g. • 非自明な生成電子スペクトル  $\neq$  ガウシアン+デルタ関数

- 生成粒子数の増大, Franz-Keldysh振動,,,

Q

電場の重ね合わせで、スピン流は流れるか？



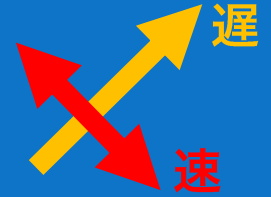
それぞれの電場はスピン流を作らないし、  
そもそも電場はスピンを区別しないから、  
重ね合わせたって、何も起きないのでは？



それぞれの電場が電流を作らないし、  
そもそも電極の極性を区別しないから、  
重ね合っても電流が流れて、何も起きないのでは？

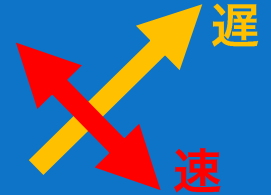
# スピン流は流れる

遅い電場と速い電場が平行でなければ、  
スピン軌道相互作用を通じて、スピン流が流れる



# スピン流は流れる

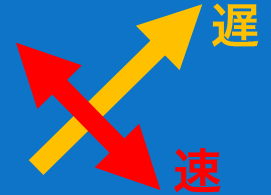
遅い電場と速い電場が平行でなければ、  
スピン軌道相互作用を通じて、スピン流が流れる



電子・正孔が電場により作られ、電場の方向に電流を流そうとする

# スピン流は流れる

遅い電場と速い電場が平行でなければ、  
スピン軌道相互作用を通じて、スピン流が流れる



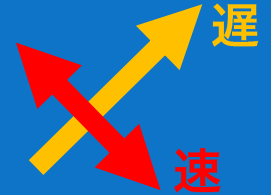
電子・正孔が電場により作られ、電場の方向に電流を流そうとする

電流は、速い電場の変化に追随しようとするが、タイムラグがある  
⇒ 電流と電場は厳密に平行でない  $j \times E \neq 0$



# スピン流は流れる

遅い電場と速い電場が平行でなければ、  
スピン軌道相互作用を通じて、スピン流が流れる



電子・正孔が電場により作られ、電場の方向に電流を流そうとする

電流は、速い電場の変化に追随しようとするが、タイムラグがある  
⇒ 電流と電場は厳密に平行でない  $j \times E \neq 0$

Dirac粒子は、 $s \cdot (j \times E)$ の形のスピン軌道相互作用を必ず持つ

cf. ・電場の中で運動をしている電子の静止系では、電場は磁場に見える

・ Dirac方程式の非相対論近似で導出可 [Foldy, Wouthuysen (1950)]  
[Tani (1951)]

2つの電場と直交する方向にスピン偏極し、スピン流が流れる

導入



**理論**



結果



まとめ

# 理論計算の概要 (1/2)

## セットアップ

- 電場中のDirac物質を考える: 
$$H = \begin{pmatrix} m I_{2 \times 2} & \boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\partial} - e\mathbf{A}) \\ -\boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\partial} - e\mathbf{A}) & -m I_{2 \times 2} \end{pmatrix}$$
- z方向に定常電場、x方向に振動電場を時間Tかける: 
$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_x \cos \Omega t \\ 0 \\ E_z \end{pmatrix} \theta(t) \theta(T - t)$$

# 理論計算の概要 (1/2)

## セットアップ

- 電場中のDirac物質を考える: 
$$H = \begin{pmatrix} m I_{2 \times 2} & \boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\partial} - e\mathbf{A}) \\ -\boldsymbol{\sigma} \cdot (i\boldsymbol{\partial} - e\mathbf{A}) & -m I_{2 \times 2} \end{pmatrix}$$
- z方向に定常電場、x方向に振動電場を時間Tかける: 
$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_x \cos \Omega t \\ 0 \\ E_z \end{pmatrix} \theta(t) \theta(T - t)$$

## 何を計算したか

- スピン流演算子の真空期待値: 
$$(J_{Si})^j \equiv \langle 0; \text{in} | : \hat{\psi}^\dagger (J_{Si})^j \hat{\psi} : | 0; \text{in} \rangle$$

ここで、 $(J_{Si})^j$ は、Bargmann-Wigner spin current で

[Bargmann, Wigner (1948)]  
[Fradkin, Good (1961)]  
[Vernes, Gyorffy,  
Weinberger (2007)]

$$(J_{Si})^j \equiv \alpha^i \left( \beta \Sigma^j + \frac{p^j}{m} \gamma_5 \right) \sim \Sigma^i v^j = \text{スピン} \times \text{速度}$$

# 理論計算の概要 (2/2)

どうやって

場の理論の演算子形式に基づいた計算：

# 理論計算の概要 (2/2)

どうやって

場の理論の演算子形式に基づいた計算：

① 場の演算子をモード展開 + 正準量子化

$$\hat{\psi}(t, \mathbf{x}) = \sum_s \int d^3\mathbf{p} [u_{\mathbf{p},s}(t, \mathbf{x}) \hat{a}_{\mathbf{p},s} + v_{\mathbf{p},s}(t, \mathbf{x}) \hat{b}_{-\mathbf{p},s}^\dagger]$$

ここで、モード関数  $u_{\mathbf{p},s}, v_{\mathbf{p},s}$  はDirac方程式  $i\partial_t \varphi_{\mathbf{p},s} = H \varphi_{\mathbf{p},s}$  を満たす

# 理論計算の概要 (2/2)

どうやって

場の理論の演算子形式に基づいた計算：

① 場の演算子をモード展開 + 正準量子化

$$\hat{\psi}(t, \mathbf{x}) = \sum_s \int d^3\mathbf{p} [u_{\mathbf{p},s}(t, \mathbf{x}) \hat{a}_{\mathbf{p},s} + v_{\mathbf{p},s}(t, \mathbf{x}) \hat{b}_{-\mathbf{p},s}^\dagger]$$

ここで、モード関数  $u_{\mathbf{p},s}, v_{\mathbf{p},s}$  はDirac方程式  $i\partial_t \varphi_{\mathbf{p},s} = H \varphi_{\mathbf{p},s}$  を満たす

② 期待値をモード関数で書き直す

$$(J_{si})^j \equiv \sum_s \int d^3\mathbf{p} [v_{\mathbf{p},s}^\dagger (J_{si})^j v_{\mathbf{p},s} - (\text{regularization})]$$

[Kluger et al (1991-1993)]  
[Tanji (2009)]

$v_{\mathbf{p},s}$  が分かれば十分  $\Rightarrow$  Dirac方程式を解けばOK

# 理論計算の概要 (2/2)

どうやって

場の理論の演算子形式に基づいた計算：

① 場の演算子をモード展開 + 正準量子化

$$\hat{\psi}(t, \mathbf{x}) = \sum_s \int d^3\mathbf{p} [u_{\mathbf{p},s}(t, \mathbf{x}) \hat{a}_{\mathbf{p},s} + v_{\mathbf{p},s}(t, \mathbf{x}) \hat{b}_{-\mathbf{p},s}^\dagger]$$

ここで、モード関数  $u_{\mathbf{p},s}, v_{\mathbf{p},s}$  はDirac方程式  $i\partial_t \varphi_{\mathbf{p},s} = H \varphi_{\mathbf{p},s}$  を満たす

② 期待値をモード関数で書き直す

$$(J_{si})^j \equiv \sum_s \int d^3\mathbf{p} [v_{\mathbf{p},s}^\dagger (J_{si})^j v_{\mathbf{p},s} - (\text{regularization})]$$

[Kluger et al (1991-1993)]  
[Tanji (2009)]

$v_{\mathbf{p},s}$  が分かれば十分  $\Rightarrow$  Dirac方程式を解けばOK

- 😊 Dirac方程式をフルに解くので、非線形効果は自動的に入る
- 😊 Dirac方程式を解いているので、スピン軌道相互作用も自動的に入る
- 😞 電子間の散乱は無視されている



導入



理論

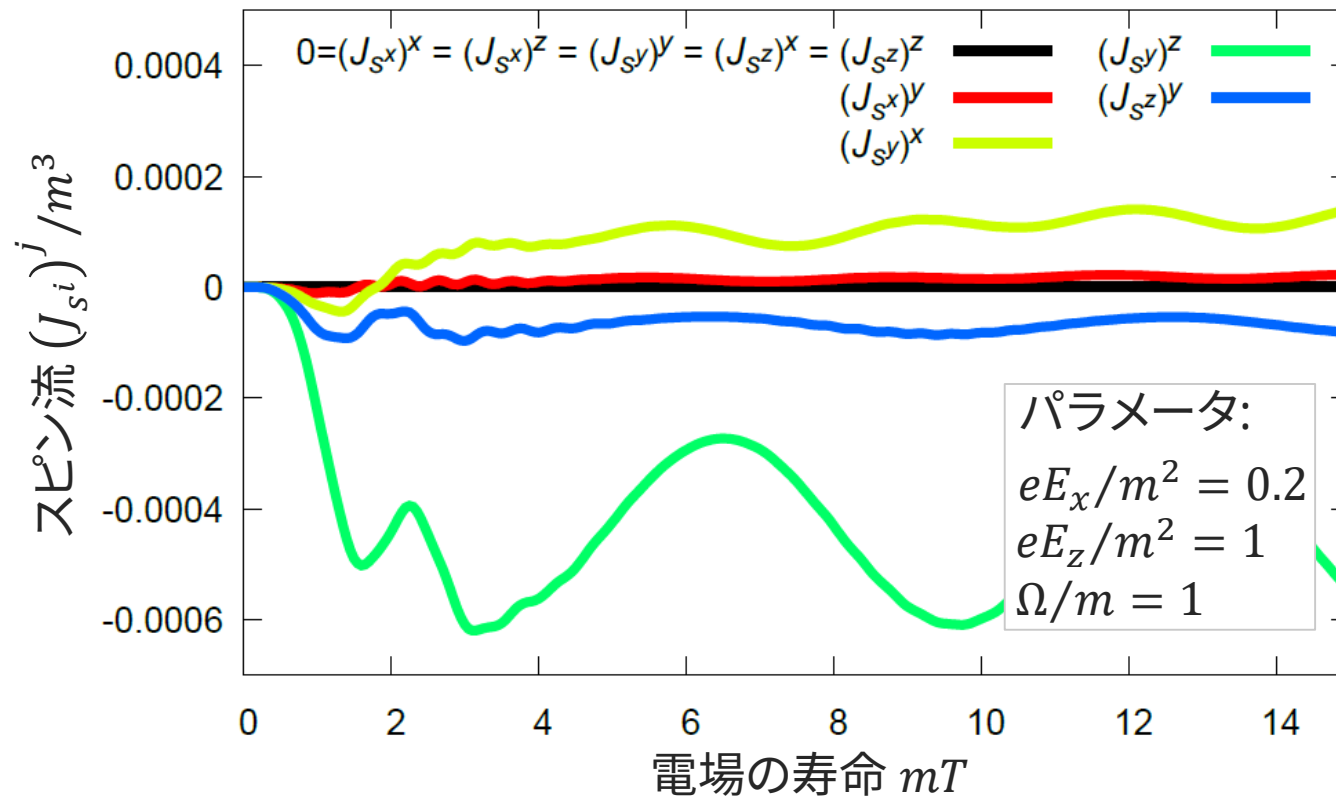


**結果**



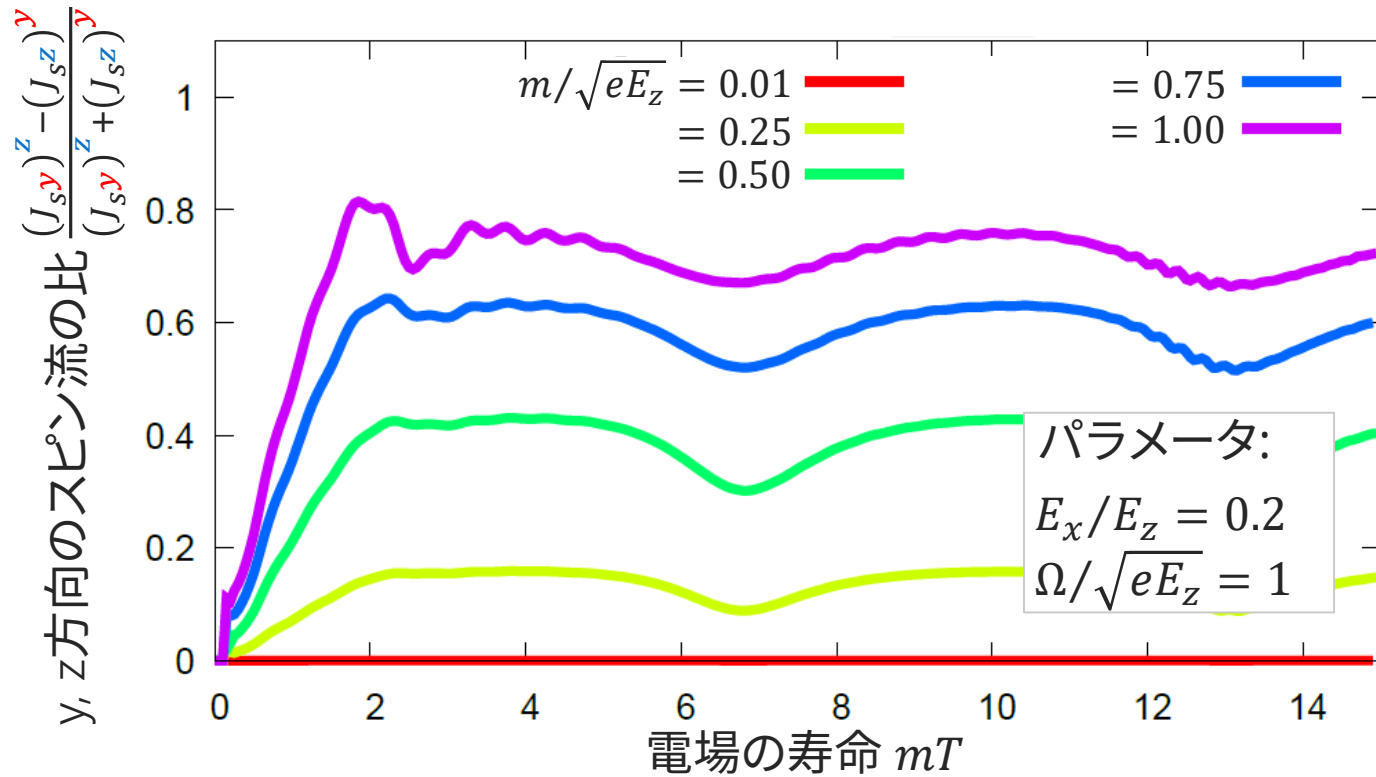
まとめ

# 結果(1/2): スピン流生成



- 予想したように、電場(x,z軸)に垂直な方向(y軸)にスピン偏極したスピン流が、電場の方向(x,z軸)が確かに流れている (緑、黄)
- 電場の方向(x,z軸)にも少しだけスピン偏極する (赤、青)

# 結果(2/2): 相対論的効果 (ヘリシティ保存)



- 質量が軽いと、相対論的効果で、スピンと運動方向が同じ方向に向こうとする

⇒ 非ゼロの  $(J_{si})^j$  が、非ゼロの  $(J_{sj})^i$  を産む

⇒ 解析的にも、証明可:  $\frac{(J_{si})^j - (J_{sj})^i}{(J_{si})^j + (J_{sj})^i} \xrightarrow{m \rightarrow 0} 0$

導入



理論



結果



**まとめ**

# まとめ

詳細は, [Huang, Matsuo, [HT](#), arXiv:1904.07593 (to appear in PTEP)]

## 高エネルギー物理のSchwinger機構 (強い電場による真空/基底状態からの粒子生成) を利用した新しいスピンの生成機構の提案

- フェルミ面がギャップ中にあるDirac物質 (QED真空, グラフェン, Dirac半金属, 半導体,...) に、2種類の電場 (遅い電場 + 横方向の速い電場) を重ねると、スピンの生成が自発的に生成
  - スピンの演算子のin-in期待値を、場の理論に基づき、数値的に評価した
  - 線形近似では記述できない非線形効果
- 伝導電子や特殊な条件 (不純物、対称性の破れ、スピン依存したバンドなど) は不要

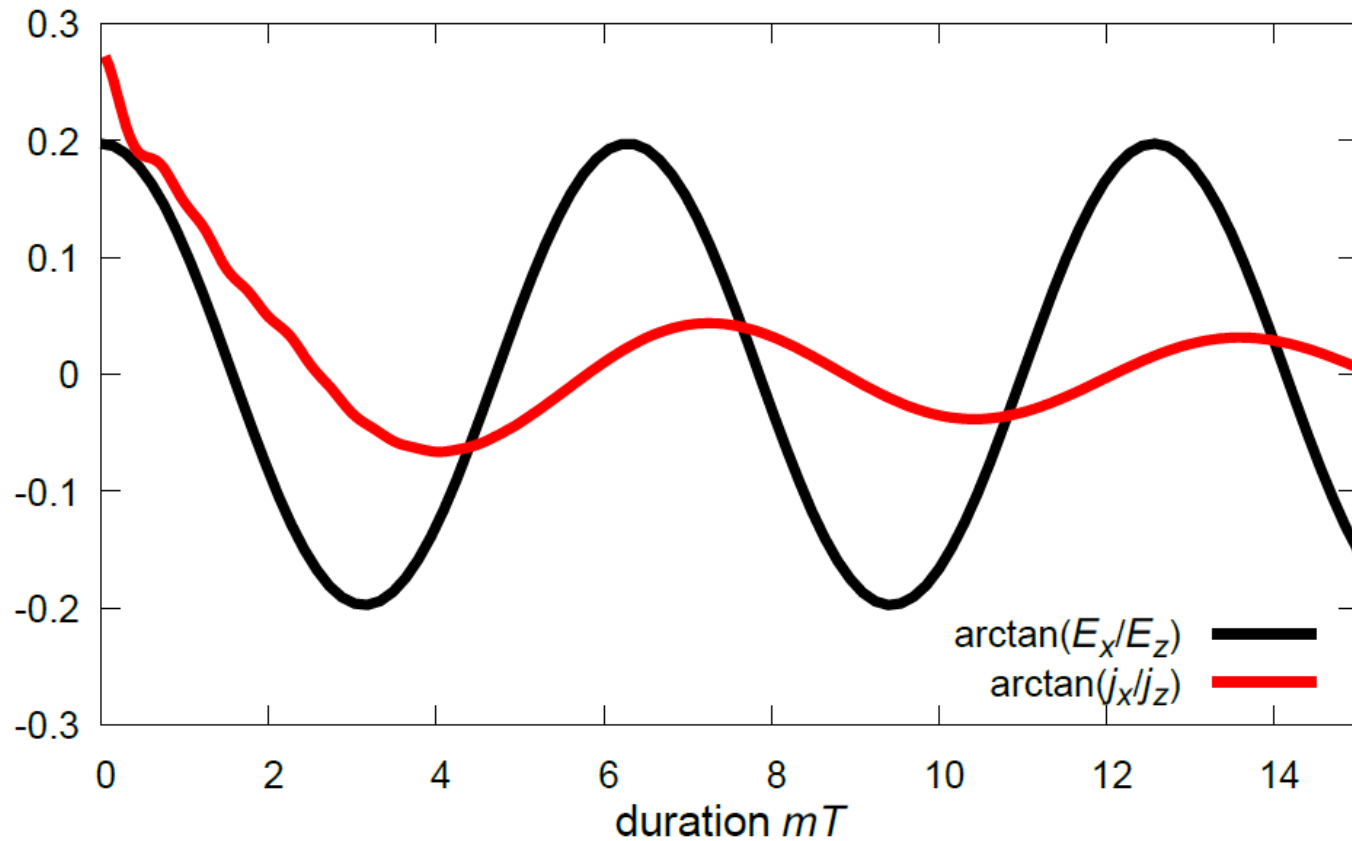
## 高エネルギー物理のアイデア/テクニックがスピントロニクスにとっても有用なことがある。逆も然り。

- Schwinger機構のさらなる応用 e.g. Schwinger機構を用いた磁化制御  
[Fujimoto, Huang, Matsuo, Ohminato, [HT](#); in prep]
- 高エネルギー重イオン衝突との交流 e.g. 相対論的スピン流体の定式化  
[Hattori, Hongo, Huang, Matsuo, [HT](#) (2019)]

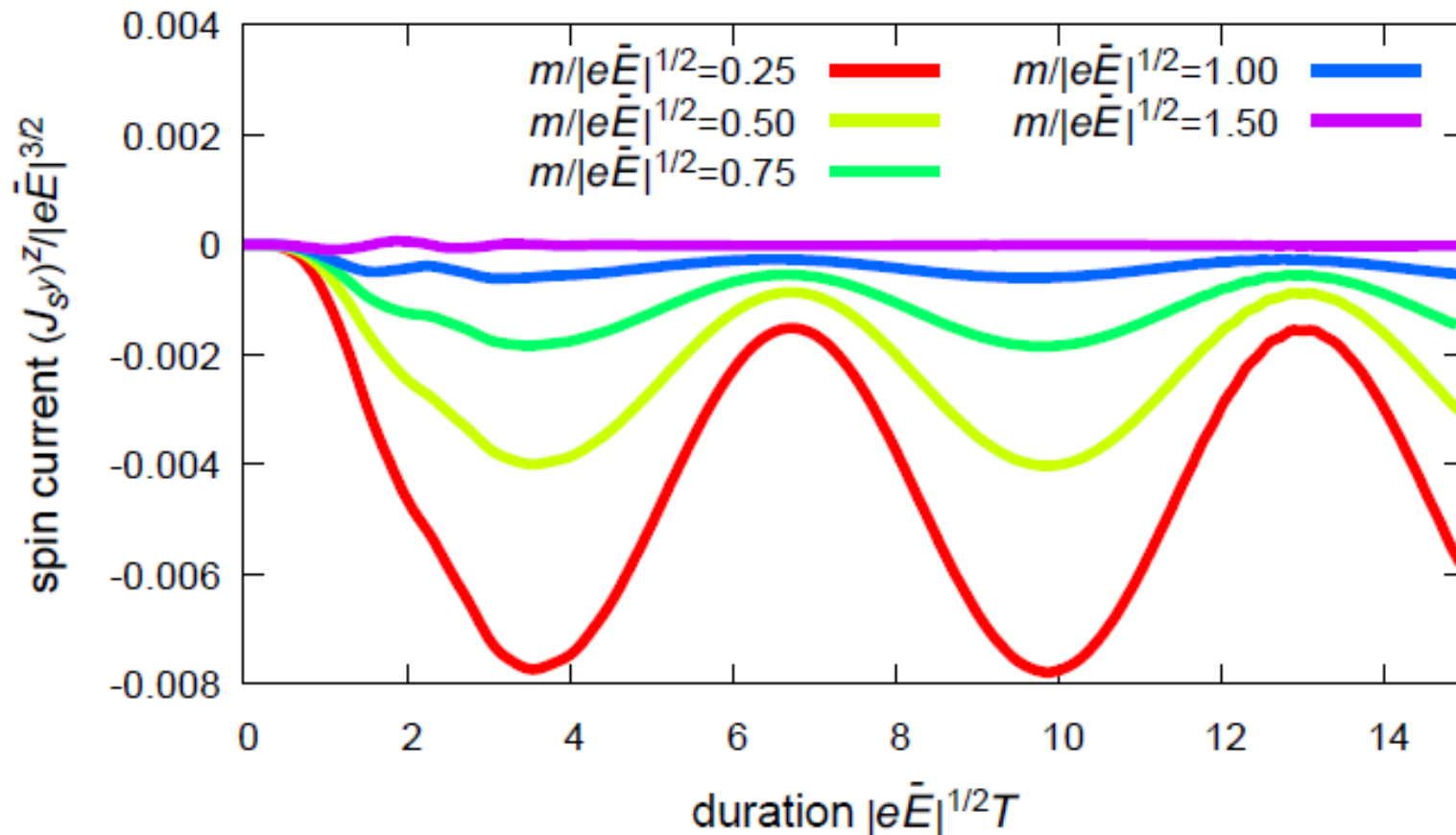
**BACK**

**UP**

# 電流と電場の方向

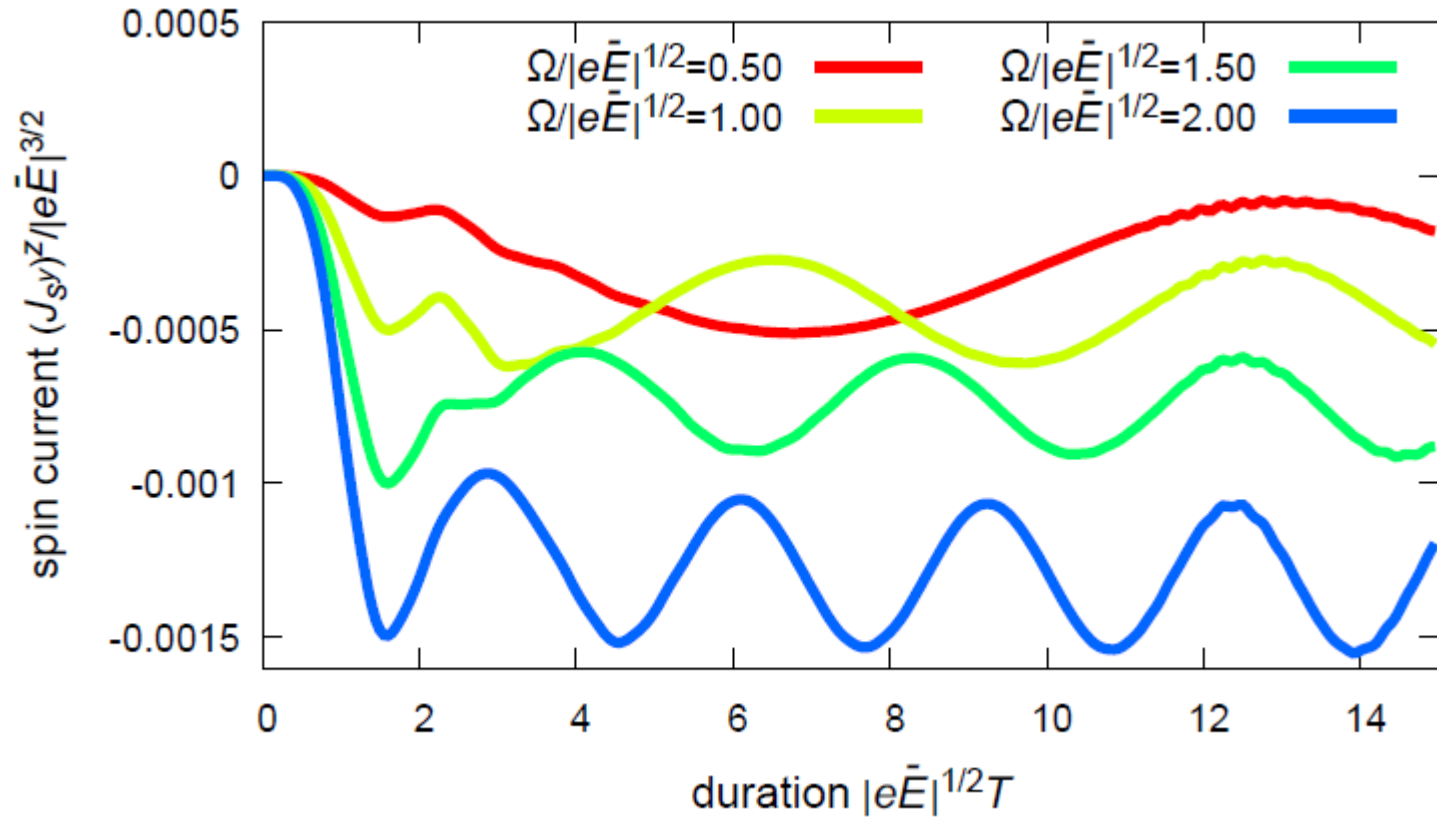


# 質量依存性

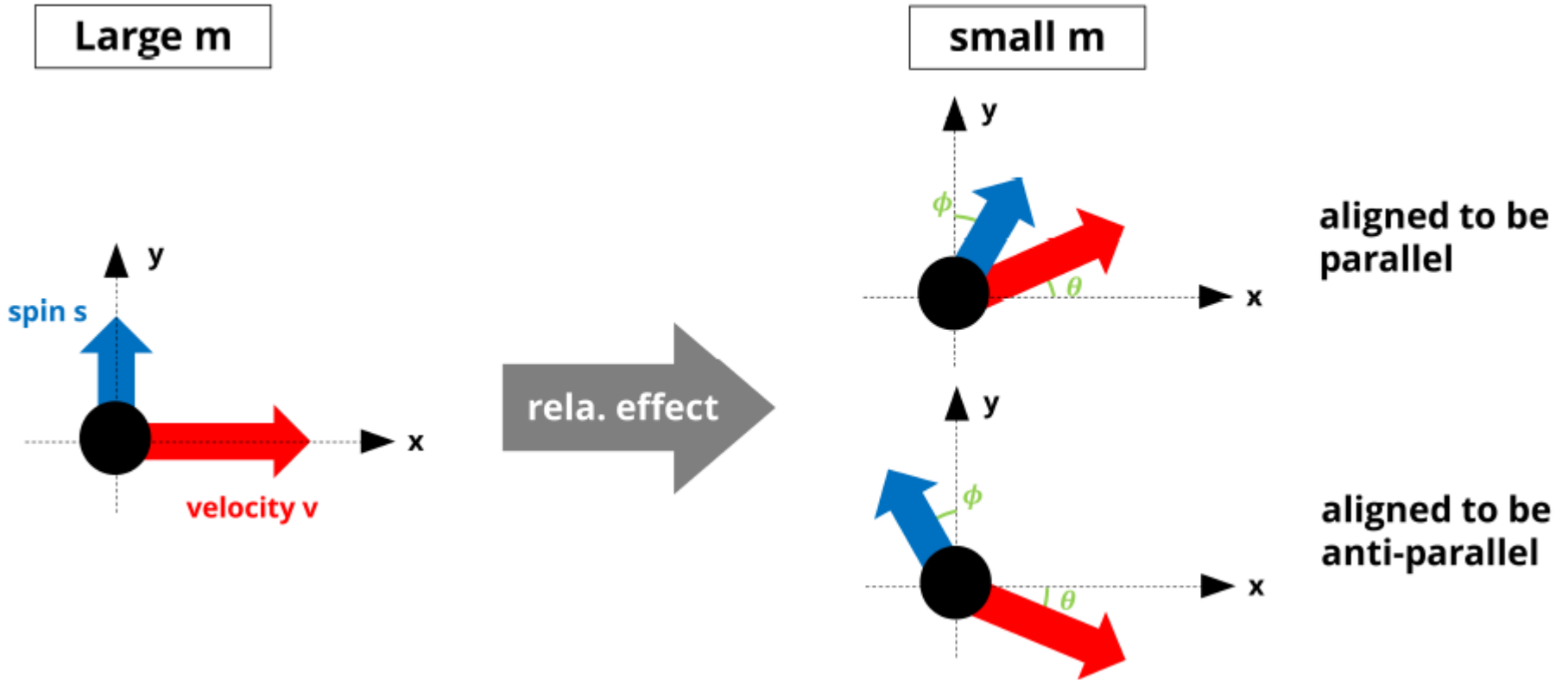




# 周波数依存性



# 相對論的效果



$$(J_{sx})^x = \sum_{\pm} (\pm s \sin \phi) \times (v \cos \theta) = 0,$$

$$(J_{sx})^y = \sum_{\pm} (\pm s \sin \phi) \times (\pm v \sin \theta) = sv \sin \phi \sin \theta,$$

$$(J_{sy})^x = \sum_{\pm} (s \cos \phi) \times (v \cos \theta) = sv \cos \phi \cos \theta,$$

$$(J_{sy})^y = \sum_{\pm} (s \cos \phi) \times (\pm v \sin \theta) = 0.$$